

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

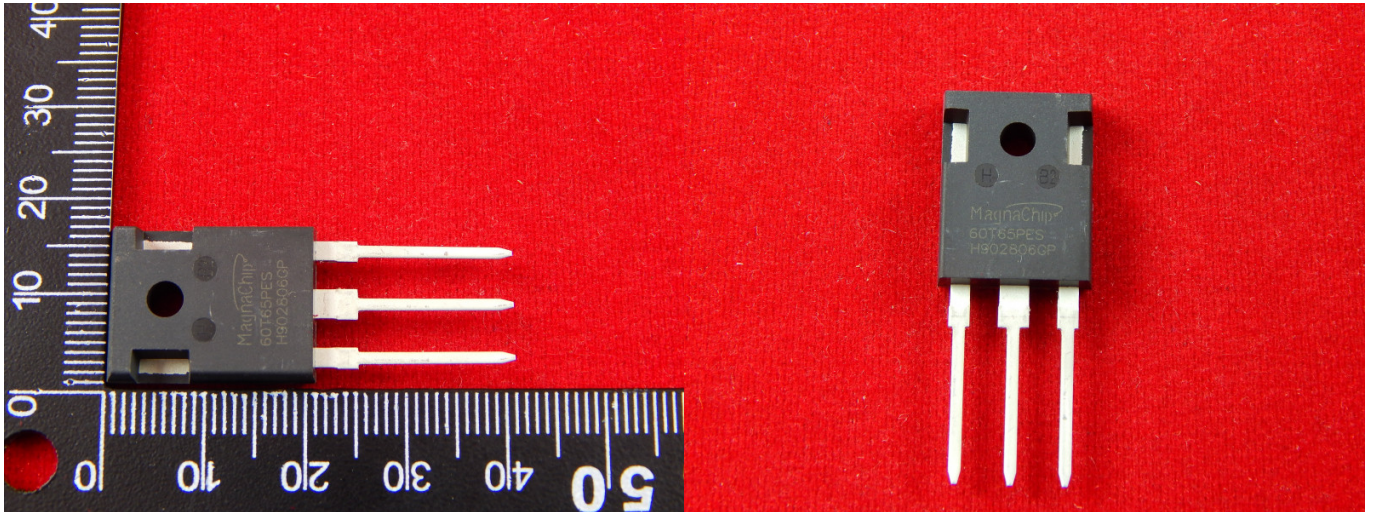
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15809

Цена в прайсе: 1761 тг.

IGBT транзистор 60T65PES, 650V, 60A, TO-247



IGBT транзистор - это довольно хитроумный прибор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.

Этот IGBT производится с использованием передовой технологии MagnaChip Field Stop Trench IGBT 2-го поколения, которая отличается не только высочайшей эффективностью коммутационного поведения, но и высокой прочностью и отличным качеством для применения в солнечных инверторах, ИБП, ИН, сварочных аппаратах и PFC, где необходимы низкие потери проводимости.

Спецификация:

- Маркировка: 60T65PES;
- Тип управляющего канала: N-Channel;
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 428;
- Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер: 650 V;
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 1.85 V;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор: ± 20 V;
- Максимальный постоянный ток коллектора: 100 A;
- Максимальная температура перехода: 175°C;
- Время нарастания: 54 ns;
- Емкость коллектора: 270 pF;
- Рабочая температура: от -40°C до +175°C;
- Корпус: TO247.

Структурная схема:

TO-247

